

Rec'd PCT/TO 26 JAN 2005 #2

PCT/JP03/09096

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

17.07.03

REC'D 05 SEP 2003

WIPO

PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 7 月 3 0 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 2 1 6 5 2
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 2 2 1 6 5 2]

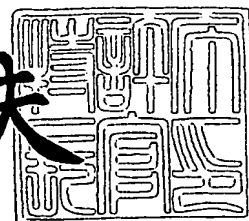
出 願 人 株式会社ブリヂストン
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 3 年 8 月 2 2 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



Best Available Copy

【書類名】 特許願

【整理番号】 BS-196

【提出日】 平成14年 7月30日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C23C 14/06
C23C 14/34

【発明の名称】 スパッタリングターゲット

【請求項の数】 4

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都小平市小川東町 3-3-6-306

 【氏名】 熊谷 祥

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県新座市栗原 6-7-10

 【氏名】 小高 文雄

【発明者】

 【住所又は居所】 埼玉県所沢市下安松 1045-2-203

 【氏名】 遠藤 茂樹

【特許出願人】

 【識別番号】 000005278

 【氏名又は名称】 株式会社ブリヂストン

【代理人】

 【識別番号】 100083806

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 三好 秀和

【選任した代理人】

 【識別番号】 100068342

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 三好 保男

【選任した代理人】

【識別番号】 100100712

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩▲崎▼ 幸邦

【選任した代理人】

【識別番号】 100087365

【弁理士】

【氏名又は名称】 栗原 彰

【選任した代理人】

【識別番号】 100079946

【弁理士】

【氏名又は名称】 横屋 赳夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100100929

【弁理士】

【氏名又は名称】 川又 澄雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100095500

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 正和

【選任した代理人】

【識別番号】 100101247

【弁理士】

【氏名又は名称】 高橋 俊一

【選任した代理人】

【識別番号】 100098327

【弁理士】

【氏名又は名称】 高松 俊雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001982

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0110473

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スパッタリングターゲット

【特許請求の範囲】

【請求項1】 SiCとSiをSiC/Si（体横比率）＝50/50～70/30で含むスパッタリングターゲット。

【請求項2】 SiC/Si（体横比率）＝55/45～65/35である請求項1に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項3】 前記SiCとSiは反応焼結法で作製された複合体である請求項1又は2に記載のスパッタリングターゲット。

【請求項4】 前記Siに含まれる不純物の重量比率が0.01%以下である請求項1～3のいずれか1項に記載のスパッタリングターゲット。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、スパッタリングターゲットに関する。さらに詳しくは基材の被覆層の屈折率を広い範囲で調整可能とするスパッタリングターゲットに関する。

【0002】

【従来の技術】

高純度SiCからなるスパッタリングターゲットが知られているが、スパッタリング装置に導入する酸素ガス、窒素ガスの流量を制御したり投入電力を制御しても、波長633nmにおける屈折率を1.4から3.5の範囲に調整するのが限界であった。

一方、高純度Siからなるスパッタリングターゲットが知られているが、その電気抵抗が $10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 以上であることから、高周波電源装置を用いなければスパッタリングを行えないという経済的不利益があった。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

そのため、酸素ガスもしくは窒素ガスの流量を制御することにより、又は投入電力を制御することにより被覆層の屈折率を広い範囲で調整可能なスパッタリン

グターゲットが求められていた。また、直流電源 (DC) 装置によるスパッタリングを可能とする、電気抵抗が $10^{-1} \Omega \cdot \text{cm} \sim 10^{-2} \Omega \cdot \text{cm}$ のスパッタリングターゲットが求められていた。

【0004】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは鋭意研究した結果、スパッタリングターゲットを SiC と Si の複合体とすることで前記課題が解決することを見出した。

【0005】

即ち、本発明は以下の記載事項に関する。

<1> SiC と Si を SiC/Si (体横比率) = 50/50 ~ 70/30 で含むスパッタリングターゲット。

<2> SiC/Si (体横比率) = 55/45 ~ 65/35 である前記<1>に記載のスパッタリングターゲット。

<3> 前記 SiC と Si は反応焼結法で作製された複合体である前記<1>又は<2>に記載のスパッタリングターゲット。

<4> 前記 Si に含まれる不純物の重量比率が 0.01% 以下である前記<1> ~ <3> のいずれか 1 つに記載のスパッタリングターゲット。

【0006】

【発明の実施の形態】

以下に、本発明をさらに詳細に説明する。

まず、本発明のスパッタリングターゲットの製造に用いられる成分について説明する。

【0007】

(炭化ケイ素粉末)

本発明に用いられる炭化ケイ素粉末として、 α 型、 β 型、非晶質あるいはこれらの混合物等が挙げられる。また、高純度の炭化ケイ素焼結体を得るためには、原料の炭化ケイ素粉末として、高純度の炭化ケイ素粉末を用いることが好ましい。

この β 型炭化ケイ素粉末のグレードには特に制限はなく、例えば、一般に市販

されている β 型炭化ケイ素を用いることができる。

炭化ケイ素粉末の粒径は、高密度の観点からは、小さいことが好ましく、具体的には、 $0.01 \sim 10 \mu\text{m}$ 程度、さらに好ましくは、 $0.05 \sim 5 \mu\text{m}$ である。粒径が、 $0.01 \mu\text{m}$ 未満であると、計量、混合等の処理工程における取扱いが困難となりやすく、 $10 \mu\text{m}$ を超えると、比表面積が小さく、即ち、隣接する粉末との接触面積が小さくなり、高密度化し難くなるため好ましくない。

高純度の炭化ケイ素粉末は、例えば、少なくとも1種以上のケイ素化合物を含むケイ素源と、少なくとも1種以上の加熱により炭素を生成する有機化合物を含む炭素源と、重合又は架橋触媒と、を溶媒中で溶解し、乾燥した後得られた粉末を非酸化性雰囲気下で焼成する工程により得ることができる。

【0008】

前記ケイ素化合物を含むケイ素源（以下、「ケイ素源」という。）として、液状のものと固体のものとを併用することができるが、少なくとも1種は液状のものから選ばれなくてはならない。液状のものとしては、アルコキシシラン（モノー、ジー、トリー、テトラー）及びテトラアルコキシシランの重合体が用いられる。アルコキシシランの中ではテトラアルコキシシランが好適に用いられ、具体的には、メトキシシラン、エトキシシラン、プロポキシシラン、ブトキシシラン等が挙げられるが、ハンドリングの点からは、エトキシシランが好ましい。また、テトラアルコキシシランの重合体としては、重合度が2～15程度の低分子量重合体（オリゴマー）及びさらに重合度が高いケイ酸ポリマーで液状のものが挙げられる。これらと併用可能な固体状のものとしては、酸化ケイ素が挙げられる。前記反応焼結法において酸化ケイ素とは、 SiO_2 の他、シリカゲル（コロイド状超微細シリカ含有液、内部にOH基やアルコキシル基を含む）、二酸化ケイ素（シリカゲル、微細シリカ、石英粉末）等を含む。これらケイ素源は、単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。

これらケイ素源の中でも、均質性やハンドリング性が良好な観点から、テトラエトキシシランのオリゴマー及びテトラエトキシシランのオリゴマーと微粉末シリカとの混合物等が好適である。また、これらのケイ素源は高純度の物質が用いられ、初期の不純物含有量が20 ppm以下であることが好ましく、5 ppm以

下であることがさらに好ましい。

【0009】

前記加熱により炭素を生成する有機化合物を含む炭素源（以下、適宜「炭素源」と称する。）としては液状のもの他、液状のものと固体のものとを併用することができ、残炭率が高く、かつ触媒もしくは加熱により重合又は架橋する有機化合物、具体的には、フェノール樹脂、フラン樹脂、ポリイミド、ポリウレタン、ポリビニルアルコール等の樹脂のモノマーやプレモノマーが好ましく、その他、セルロース、蔗糖、ピッチ、タール等の液状物が挙げられ、特にレゾール型フェノール樹脂が好ましい。これら炭素源は、単独で用いてもよいし、2以上併用してもよい。また、その純度は目安により適宜制御選択可能であるが、特に高純度の炭化ケイ素粉末が必要な場合には、各金属を5ppm以上含有していない有機化合物を用いることが望ましい。

【0010】

高純度の炭化ケイ素粉末の製造に用いられる重合及び架橋触媒としては、炭素源に応じて適宜選択でき、炭素源がフェノール樹脂やフラン樹脂の場合、トルエンスルホン酸、トルエンカルボン酸、酢酸、しゅう酸、硫酸等の酸類が挙げられる。これらの中でも、トルエンスルホン酸が好適に用いられる。

【0011】

前記反応焼結法に使用される原料粉末である高純度炭化ケイ素粉末を製造する工程における、炭素とケイ素の比（以下、C/Si比と略記）は、混合物を1000℃にて炭化して得られる炭化物中間体を、元素分析することにより定義される。化学量論的には、C/Si比が3.0の時に生成炭化ケイ素中の遊離炭素が0%となるはずであるが、実際には同時に生成するSiOガスの揮散により低C/Si比において遊離炭素が発生する。この生成炭化ケイ素粉末中の遊離炭素量が焼結体等の製造用途に適當でない量にならないように予め配合を決定することが重要である。通常、1気圧近傍で1600℃以上での焼成では、C/Si比を2.0～2.5にすると遊離炭素を抑制することができ、この範囲を好適に用いることができる。C/Si比を2.55以上にすると遊離炭素が頭著に増加するが、この遊離炭素は粒成長を抑制する効果を持つため、粒子形成の目的に応じて

適宜選択しても良い。但し、雰囲気圧力を低圧又は高圧とする場合は、純粋な炭化ケイ素を得るためのC/Si比は変動するので、この場合は必ずしも前記C/Si比の範囲に限定するものではない。

【0012】

前記反応焼結法において、ケイ素源と加熱により炭素を生成する有機化合物を含む炭素源とを、溶媒中に溶解し、乾燥して粉末を得るために、ケイ素源と該有機化合物を含む炭素源との混合物を硬化して粉末とすることも必要に応じて行われる。硬化の方法としては、加熱により架橋する方法、硬化触媒により硬化する方法、電子線や放射線による方法が挙げられる。硬化触媒としては、炭素源に応じて適宜選択できるが、フェノール樹脂やフラン樹脂の場合には、トルエンスルホン酸、トルエンカルボン酸、酢酸、しゅう酸、塩酸、硫酸、マレイン酸等の酸類、ヘキサミン等のアミン類等を用いる。これらの混合触媒を溶媒に、溶解又は分散させて混合させる。溶媒としては、低級アルコール（例えばエチルアルコール等）、エチルエーテル、アセトン等が挙げられる。

【0013】

ケイ素源と加熱により炭素を生成する有機化合物を含む炭素源とを、溶媒中に溶解し、乾燥した粉末は、加熱炭化される。これは窒素又はアルゴン等の非酸化性雰囲気中800℃～1000℃にて30分～120分間、該粉末を加熱することにより行われる。

【0014】

さらに、この炭化物をアルゴン等の非酸化雰囲気中1350℃～2000℃で加熱することにより炭化ケイ素が生成する。焼成温度と時間は希望する粒径等の特性に応じて適宜選択するが、より効率的な生成のためには1600℃～1900℃での焼成が好ましい。

また、より高純度の炭化ケイ素粉末を必要とするときには、前述の焼成時に2000℃～2100℃にて5～20分間加熱処理を施すことにより不純物をさらに除去できる。

【0015】

以上より、特に高純度の炭化ケイ素粉末を得る方法としては、本願出願人が先

に出願した特開平9-48605号の単結晶の製造方法に記載の原料粉末の製造方法、即ち、高純度のテトラアルコキシシラン、テトラアルコキシシラン重合体から選択される1種以上をケイ素源とし、加熱により炭素を生成する高純度有機化合物を炭素源とし、これらを均質に混合して得られた混合物を非酸化性雰囲気下において加熱焼成して炭化ケイ素粉末を得る炭化ケイ素生成工程と、得られた炭化ケイ素粉末を、1700℃以上2000℃未満の温度に保持し、該温度の保持中に、2000℃～2100℃の温度において5～20分間にわたり加熱する処理を少なくとも1回行う後処理工程とを含み、前記2工程を行うことにより、各不純物元素の含有量が0.5ppm以下である炭化ケイ素粉末を得ること、を特徴とする高純度炭化ケイ素粉末の製造方法等を利用することができる。この様にして得られた炭化ケイ素粉末は、大きさが不均一であるため、解粉、分級により前記粒度に適合するように処理する。

【0016】

炭化ケイ素粉末を製造する工程において窒素を導入する場合は、まずケイ素源と、炭素源と、窒素源からなる有機物質と、重合又は架橋触媒と、を均質に混合するが、前述の如く、フェノール樹脂等の炭素源と、ヘキサメチレンテトラミン等の窒素源からなる有機物質と、トルエンスルホン酸等の重合又は架橋触媒とを、エタノール等の溶媒に溶解する際に、テトラエトキシシランのオリゴマー等のケイ素源と十分に混合することが好ましい。

【0017】

(炭素源)

炭素源として用いられる物質は、加熱により炭素を生成する高純度有機化合物であるが、炭素源となる有機化合物は単独で用いてもよいし、2種以上併用してもよい。加熱により炭素を生成する有機化合物としては導電性が付与されているものが好ましく、具体的には、残炭率の高いフェノール樹脂、フuran樹脂、エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂やグルコース等の単糖類、蔗糖等の少糖類、セルロース、デンプン等の多糖類などの各種糖類が挙げられる。これらは炭化ケイ素粉末と均質に混合するという目的から、常温で液状のもの、溶媒に溶解するもの、熱可塑性あるいは熱融解性のように加熱することにより軟化するものあるいは液状

となるものが主に用いられるが、なかでも、得られる成形体の強度の高いフェノール樹脂、特に、レゾール型フェノール樹脂が好適に使用される。

【0018】

(ケイ素源)

ケイ素源としては、高純度のテトラアルコキシシラン、その重合体、酸化ケイ素から選択される1種以上を用いる。本発明において、酸化ケイ素とは、二酸化ケイ素、一酸化ケイ素を包含するものとする。ケイ素源としては、具体的には、テトラエトキシシランに代表されるアルコキシシラン、その低分子量重合体（オリゴマー）、及び、さらに重合度が高いケイ酸ポリマー等や、シリカゾル、微粉体シリカ等の酸化ケイ素化合物が挙げられる。アルコキシシランとしては、メトキシシラン、エトキシシラン、プロポキシシラン、ブトキシシラン等が例示され、なかでも、ハンドリング性の観点から、エトキシシランが好ましく用いられる。

ここでオリゴマーとは重合度2～15程度の重合体を指す。これらケイ素源のなかでも、均質性やハンドリング性が良好な観点から、テトラエトキシシランのオリゴマー及びテトラエトキシシランのオリゴマーと微粉体シリカとの混合物等が好適である。また、これらのケイ素源は高純度の物質が用いられ、初期の不純物含有量が20ppm以下であることが好ましく、5ppm以下であることがさらに好ましい。また、前記Siに含まれる不純物の重量比率が0.01%以下であることが好ましい。

【0019】

(SiC/Si (体横比率))

本発明におけるスパッタリングターゲットは、SiCとSiをSiC/Si (体横比率) = 50/50～70/30で含み、さらに好ましくはSiC/Si (体横比率) = 55/45～65/35で含む。

このような構成とすることで体積抵抗が低く、しかも、被覆層の屈折率を広範囲で設定することができるスパッタリングターゲットが得られることとなる。

【0020】

(スパッタリングターゲットの製造方法)

続いて、反応焼結法を用いたスパッタリングターゲットの製造方法について、好ましい 1 実施態様を挙げて説明する。

本発明にかかるスパッタリングターゲットの製造方法の好ましい 1 実施態様は、(1) 炭化ケイ素粉末と、炭素源とを溶媒中に溶解、分散し、スラリー状の混合粉体を製造する工程と、(2) 得られた混合粉体を成形型に流し込み乾燥させてグリーン体を得る工程と、(3) 得られたグリーン体を真空雰囲気又は不活性ガス雰囲気下 1200～1800℃で仮焼して仮焼体を得る工程と、(4) 得られた仮焼体に毛細管現象により溶融した金属シリコンを含浸させ、前記仮焼体中の遊離炭素と毛細管現象により前記仮焼体中に吸い上げられたシリコンとを反応させることにより炭化ケイ素体を得る工程と、を有する。以下、前記スパッタリングターゲットの製造方法について各工程毎に詳細に説明する。

【0021】

(1) スラリー状の混合粉体を製造する工程について

スラリー状の混合粉体は、炭化ケイ素粉末と、炭素源と、所望により有機バインダーや消泡剤を溶媒中に溶解又は分散することにより製造される。溶解、分散時に、十分に攪拌混合することにより、グリーン体中に均一に気孔を分散させることができる。

前記溶媒としては、水、エチルアルコール等の低級アルコール類やエチルエーテル、アセトン等が挙げられる。溶媒は不純物の含有量が低いものを使用することが好ましい。

また、炭化ケイ素粉末からスラリー状の混合粉体を製造する際に、有機バインダーを添加してもよい。有機バインダーとしては、解膠剤、粉体粘着剤等が挙げられ、解膠剤としては、導電性を付与する効果をさらに上げる点で窒素系の化合物が好ましく、例えばアンモニア、ポリアクリル酸アンモニウム塩等が好適に用いられる。粉体粘着剤としては、ポリビニルアルコールウレタン樹脂（例えば水溶性ポリウレタン）等が好適に用いられる。

また、その他、消泡剤を添加してもよい。消泡剤としては、シリコーン消泡剤等が挙げられる。

前記攪拌混合は、公知の攪拌混合手段、例えば、ミキサー、遊星ボールミルな

どによって行うことができる。攪拌混合は、6～48時間、特に、12～24時間に渡って行うことが好ましい。

【0022】

(2) グリーン体を得る工程について

スラリー状の混合粉体を型に流しこみ成形するには、一般的に鑄込み成形が好適に用いられる。スラリー状の混合粉体を鑄込み成形時の成形型に流し込み、放置、脱型した後、40～60℃の温度条件下で加熱乾燥又は自然乾燥して溶媒を除去することにより、規定寸法のグリーン体を得ることができる。

本発明において、「グリーン体」とは、スラリー状の混合粉体から溶媒を除去して得られる、多くの気孔が内在する反応焼結前の炭化ケイ素成形体を意味する。

【0023】

(3) 仮焼体を得る工程について

高い曲げ強度を有するスパッタリングターゲットを得るためには、焼成前にグリーン体を仮焼することが好ましい。この仮焼き工程により、乾燥だけでは除去しきれなかった微量の水分、及び解膠剤、バインダー等の有機成分を完全に除去することができる。

仮焼きの温度は1200～1800℃、好ましくは1500～1800℃である。1200℃未満であると、グリーン体中の炭化ケイ素粉体間の接触が十分に促進されず接触強度が不足し取扱いが不便となり、また、1800℃を超えると、グリーン体中の炭化ケイ素粉体の粒成長が著しくなり、その後の熔融高純度シリコンの浸透が不十分となる。

前記仮焼の昇温速度は、800℃までは1～3℃/minが好ましく、800℃から最高温度までは5～8℃/minが好ましいが、グリーン体の形状、大きさ等を考慮して適宜決定するのがよい。

前記仮焼の最高温度保持時間は、10～120分が好ましく、20～60分がより好ましいが、グリーン体の形状、大きさ等を考慮して適宜決定するのがよい。

前記仮焼は、酸化防止の観点から真空雰囲気又は不活性ガス雰囲気下で行うこと

が好適である。

この仮焼きにより、室温における曲げ強度が300MPa以上の焼結体を得ることができる。また、複雑な形状でもクラック、ひび割れ等の欠陥のない焼結体を得ることが可能となる。

【0024】

本発明において、「仮焼体」とは、前記グリーン体を仮焼することにより得られる、気孔や不純物が取り除かれた反応焼結前の炭化ケイ素成形体を意味する。

【0025】

(4) 炭化ケイ素焼結体を得る工程について

前記工程を経て製造された仮焼体を、真空雰囲気又は不活性ガス雰囲気下、高純度金属シリコンの融点以上、具体的には1450～1700℃迄加熱して溶融した高純度金属シリコン中に浸漬する。仮焼体を溶融金属シリコン中に浸漬することにより、液状になったシリコンが、毛細管現象により仮焼体中の気孔に浸透し、このシリコンと仮焼体中の遊離炭素とが反応する。この反応により炭化ケイ素が生成し、仮焼体中の気孔が生成された炭化ケイ素によって充填される。

シリコンと遊離炭素との反応は、炭化ケイ素粉末を製造する工程で示したように1420～2000℃程度で起こるので、1450～1700℃迄加熱された溶融高純度金属シリコンが、焼結体中に浸透した段階で、遊離炭素との反応が進行する。

また、仮焼体を溶融金属シリコン中に浸漬する時間は、特に限定されず、大きさや、仮焼体中の遊離炭素の量により適宜決定する。高純度金属シリコンは、1450～1700℃迄、好ましくは、1550～1650℃迄加熱して溶融させるが、この溶融温度が1450℃未満では高純度金属シリコンの粘性が上昇するため毛細管現象により仮焼体に浸透しなくなり、また1700℃を超えると蒸発が著しくなり炉体等に損傷を与えてしまう。

高純度金属シリコンとしては、粉末、顆粒、塊状の金属シリコンが等が挙げられ、2～5mmの塊状の金属シリコンが好適に用いられる。本発明において、高純度とは、不純物の含有量が1ppm未満のものを意味する。

前記のように仮焼体中に含まれる遊離炭素とシリコンとを反応させて、生成し

た炭化ケイ素が仮焼体中の気孔を埋めることにより、高密度な、かつ良好な電気的特性を有するスパッタリングターゲットが得られる。

前記反応焼結法において、本発明の前記加熱条件を満たしうるものであれば、特に製造装置等に制限はなく、公知の加熱炉内や反応装置を使用することができる。

【0026】

本発明で得られるスパッタリングターゲットの不純物の総含有量は、5 ppm未満、好ましくは3 ppm未満、より好ましくは1 ppm未満であるが、半導体工業分野への適用の観点からは、これらの化学的な分析による不純物含有量は参考値としての意味を有するに過ぎない。実用的には、不純物が均一に分布しているか、局所的に偏在しているかによっても評価が異なってくる。

【0027】

(使用方法)

本発明のスパッタリングターゲットを用いて従来公知のスパッタリング方法に従って基材にスパッタリングを行うことで基材に炭化ケイ素被覆層を設けることができる。

スパッタリング法により製造される炭化ケイ素質被覆層の光透過率、屈折率、光反射率等の光特性は、スパッタリング時の投入電力と、酸素ガス又は窒素ガスの導入流量（該導入流量はゼロ（導入なし）であってもよい）と、スパッタリング時間（つまり炭化ケイ素質被覆層の形成厚み）と、によって制御することができる。

本発明のスパッタリングターゲットは後述するように導電性があるため直流電源（DC）装置を用いて、言い換えるとDCスパッタリング、DCマグネトロンスパッタリングを用いてスパッタリングを行うことができる。

成膜の基本条件として、到達真空圧は 3×10^{-4} Pa以下（さらに詳しくは 4×10^{-5} Pa $\sim 3 \times 10^{-4}$ Pa）であることが好ましい。また、成膜時真空圧は、Arガスの導入流量が10 ccmの時に 6.7×10^{-1} Pa（5 mtorr）以下であることが好ましい。また、基板温度は室温であることが好ましい。

尚、基材としてはガラス、セラミックス等の無機材料、金属材料、PMMA、PET等の有機材料を用いることができる。

【0028】

【実施例】

以下に実施例及び比較例を示して本発明について具体的に説明するが、本発明が以下の実施例に限定されるものでないことは言うまでもない。

<スパッタリングターゲットの調製>

(調製例1) PB-Rの調製

前記詳細な説明の欄に記載した反応焼結法に従って、SiC/Si（体積比率）が本発明の範囲内にあるSiCとSiとを含むスパッタリングターゲット（以下、「PB-R」ともいう。）を調製した。

尚、スパッタリングを行う際に直径100mm×5mm厚に成形したものをスパッタリングターゲット材として用いた。

(調製例2) PB-Sの調製

本出願人らが先に出願した出願明細書（特開平10-67565）に開示されたホットプレス法に従ってSiCからなるスパッタリングターゲット（以下、「PB-S」ともいう。）を調製した。

尚、スパッタリングを行う際に直径100mm×5mm厚に成形したものをスパッタリングターゲット材として用いた。

【0029】

<スパッタリング方法>

以下の条件下でスパッタリングを行った。

スパッタリング装置：プレーナマグネトロンスパッタ装置（日本真空技術（株）製）、電源：直流（DC）、基材：ガラス板、前記ターゲット材と基板間距離：70mm、前記スパッタリング装置内の到達真空圧： 3×10^{-4} Pa以下、基板温度：室温、屈折率測定：エリプソメトリー（日本分光製）

【0030】

(実施例1／比較例1)

投入電力量と屈折率との関係を見るべく、表1に示されるように供給ガス量を

一定に保ちつつ、投入電力量を1000(W)、500(W)、100(W)に変化させてスパッタリングを行った。得られた結果を図1及び2に示す。

【0031】

【表1】

表1

	ターゲット材	供給ガス量(CCM)			投入電力量(W)
		Ar	N ₂	O ₂	
実施例1	PB-R	10	0	0	1000、500、100、
比較例1	PB-S	10	0	0	1000、500、100、

【0032】

(実施例2、3／比較例2、3)

供給ガス(N₂、O₂)量と屈折率との関係を見るべく、表2に示されるようにArガスの供給量と投入電力量を一定に保ちつつ、N₂又はO₂量を変化させてスパッタリングを行った。得られた結果を図3～6に示す。

【0033】

【表2】

表2

		ターゲット材	投入電力量(W)	供給ガス量(CCM)		
				Ar	N ₂	O ₂
実施例	2	PB-R	500	10	0～6	0
	3	PB-R	500	10	0	0～6
比較例	2	PB-S	500	10	0～6	0
	3	PB-S	500	10	0	0～6

【0034】

前記実施例1～3及び前記比較例1～3の測定光波長633nmにおける屈折率を表3にまとめて示す。

【0035】

【表 3】

表3

		ターゲット材	投入電力 (W)	供給ガス量 (CCM)			屈折率	
				Ar ₂	N ₂	O ₂	n	k
実施例	1	PB-R	500	10	0	0	4.14	0.50
				10	1	0	3.07	0.15
				10	2	0	2.62	0.06
				10	3	0	2.37	0.04
				10	4	0	2.26	0.04
				10	5	0	2.18	0.04
				10	6	0	2.13	0.03
	2	PB-R	500	10	0	0	4.14	0.50
				10	0	1	3.52	0.29
				10	0	2	2.51	0.07
				10	0	3	1.60	0.02
				10	0	4	1.40	0.01
				10	0	5	1.40	0.00
				10	0	6	1.41	0.00
	3	PB-R	1000 500 100	10	0	0	4.16	0.50
10				0	0	4.14	0.50	
10				0	0	4.04	0.46	
比較例	1	PB-R	500	10	0	0	3.35	0.25
				10	1	0	2.76	0.11
				10	2	0	2.53	0.09
				10	3	0	2.38	0.09
				10	4	0	2.30	0.09
				10	5	0	2.24	0.09
				10	6	0	2.21	0.08
	2	PB-R	500	10	0	0	3.35	0.25
				10	0	1	2.82	0.13
				10	0	2	2.03	0.06
				10	0	3	1.63	0.04
				10	0	4	1.45	0.01
				10	0	5	1.42	0.00
				10	0	6	1.40	0.00
	3	PB-R	1000 500 100	10	0	0	3.36	0.24
				10	0	0	3.35	0.25
				10	0	0	3.33	0.26
	備考		測定光波長: 633nm					

【0036】

スパッタ膜の体積抵抗を調べるべく、前記のように調製したスパッタリングターゲットを表に示す条件でスパッタリングを行い、そして体積抵抗を調べた。
実験条件と実験結果をまとめて表4に示す。

【0037】

【表 4】

表 4

ターゲット	Ar ガス導入流量 (ccm)	活性ガス導入流量 (ccm)	投入電力 (W)	測定時の印加電圧 (V)	体積抵抗 ($\Omega \cdot \text{cm}$)
P B-S	10	0	100	10	1.7×10^2
P B-S	10	0	500	10	1.7×10^2
P B-S	10	0	1000	10	1.7×10^2
P B-S	10	N ₂ : 0.5	500	50	3.0×10^3
P B-S	10	O ₂ : 0.5	500	50	6.6×10^2
P B-R	10	0	100	10	3.7×10^1
P B-R	10	0	500	10	2.4×10^1
P B-R	10	0	1000	10	2.2×10^1
備考	測定装置: Roresta-GP MCP-T600, ASPプローブ				

【0038】

以上の実験結果より、本発明のスパッタリングターゲットを用いることで被覆層の屈折率を広範囲で設定できることが分かった。また本発明のスパッタリングターゲットは体積抵抗が低いことより直流電源 (DC) 装置を用いてスパッタリングを行えることが分かった。

【0039】

【発明の効果】

本発明によれば、酸素ガスもしくは窒素ガスの流量を制御することにより、又は投入電力を制御することにより被覆層の屈折率を広い範囲で調整可能なスパッタリングターゲットが得られる。

また、本発明によれば、直流電源 (DC) 装置によるスパッタリングを可能とするスパッタリングターゲットが得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

図 1 は、投入電力量と屈折率との関係を示す図である。

【図 2】

図 2 は、投入電力量と屈折率との関係を示す図である。

【図 3】

図 3 は、供給ガス量 (N₂) と屈折率との関係を示す図である。

【図 4】

図 4 は、供給ガス量 (O_2) と屈折率との関係を示す図である。

【図 5】

図 5 は、供給ガス量 (N_2) と屈折率との関係を示す図である。

【図 6】

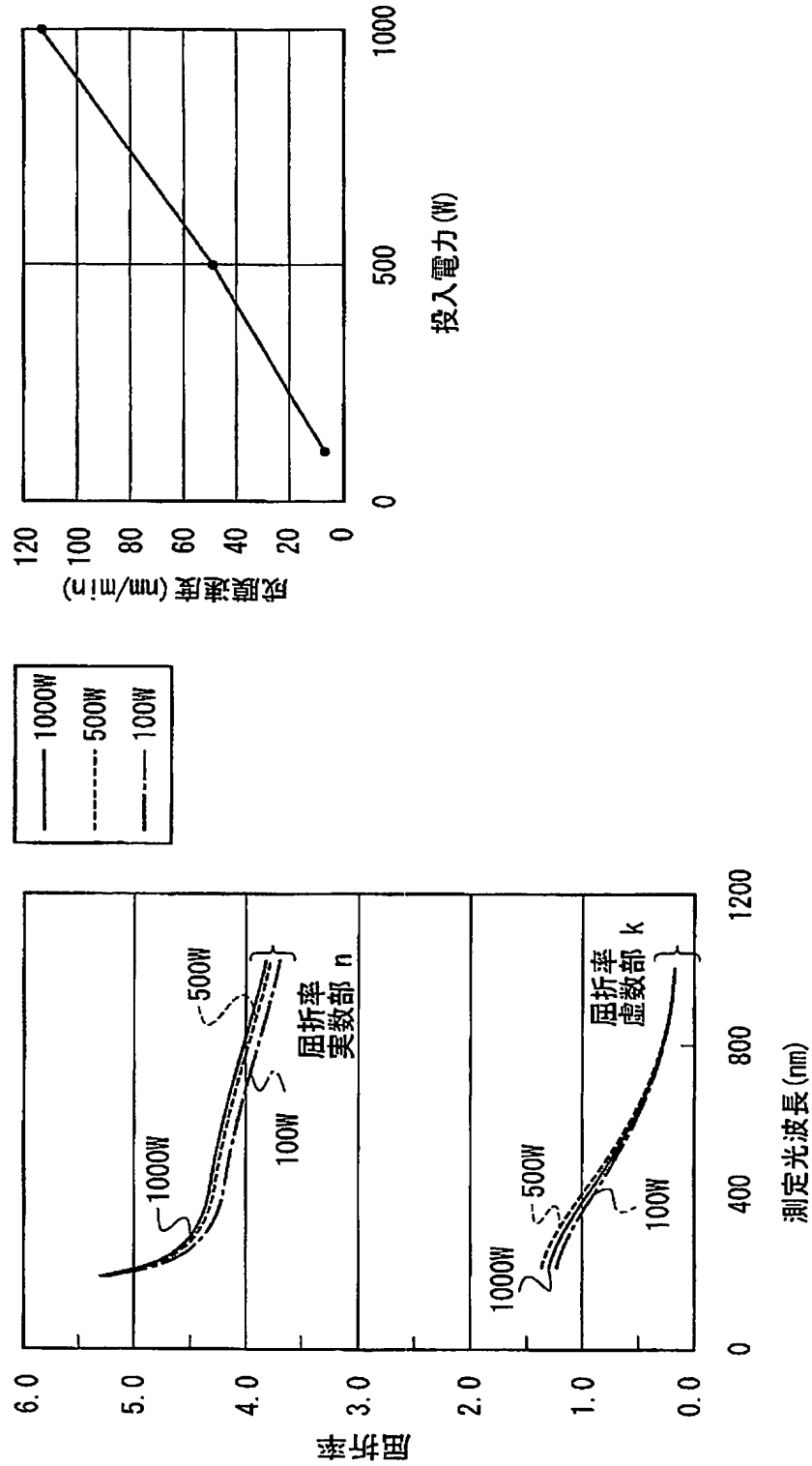
図 6 は、供給ガス量 (O_2) と屈折率との関係を示す図である。

【書類名】

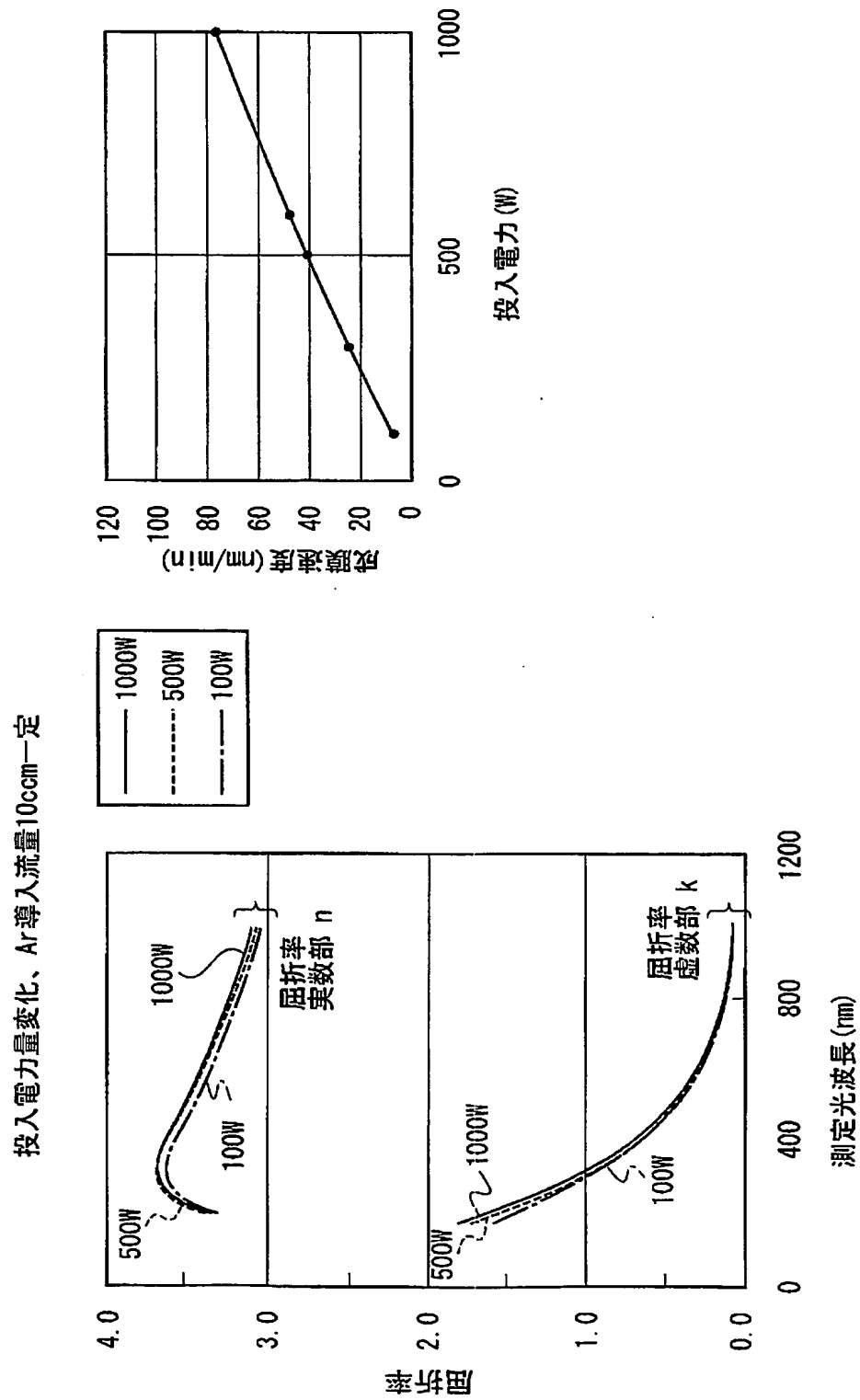
図面

【図 1】

投入電力量変化、Ar導入流量10ccm一定

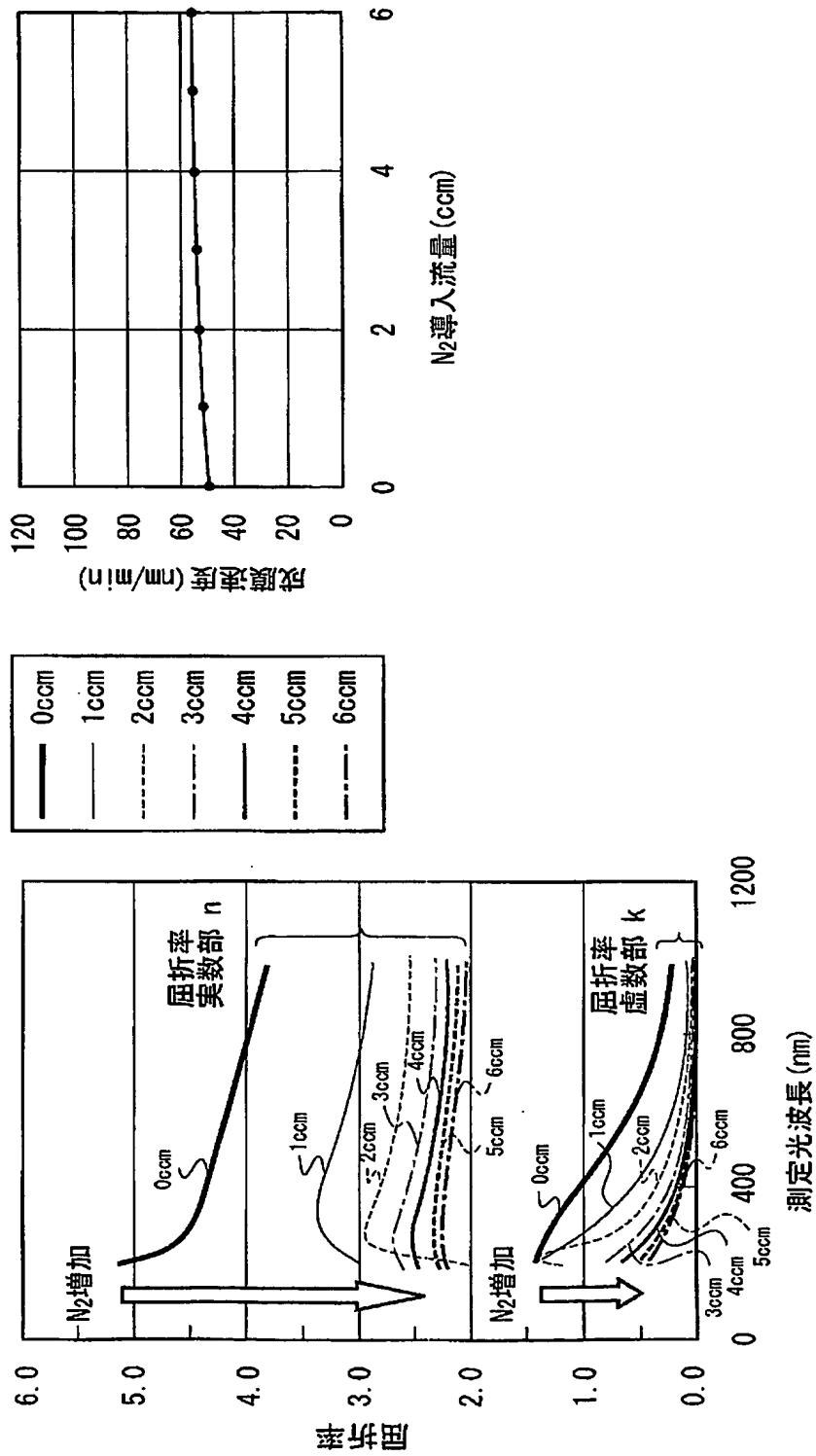


【図 2】



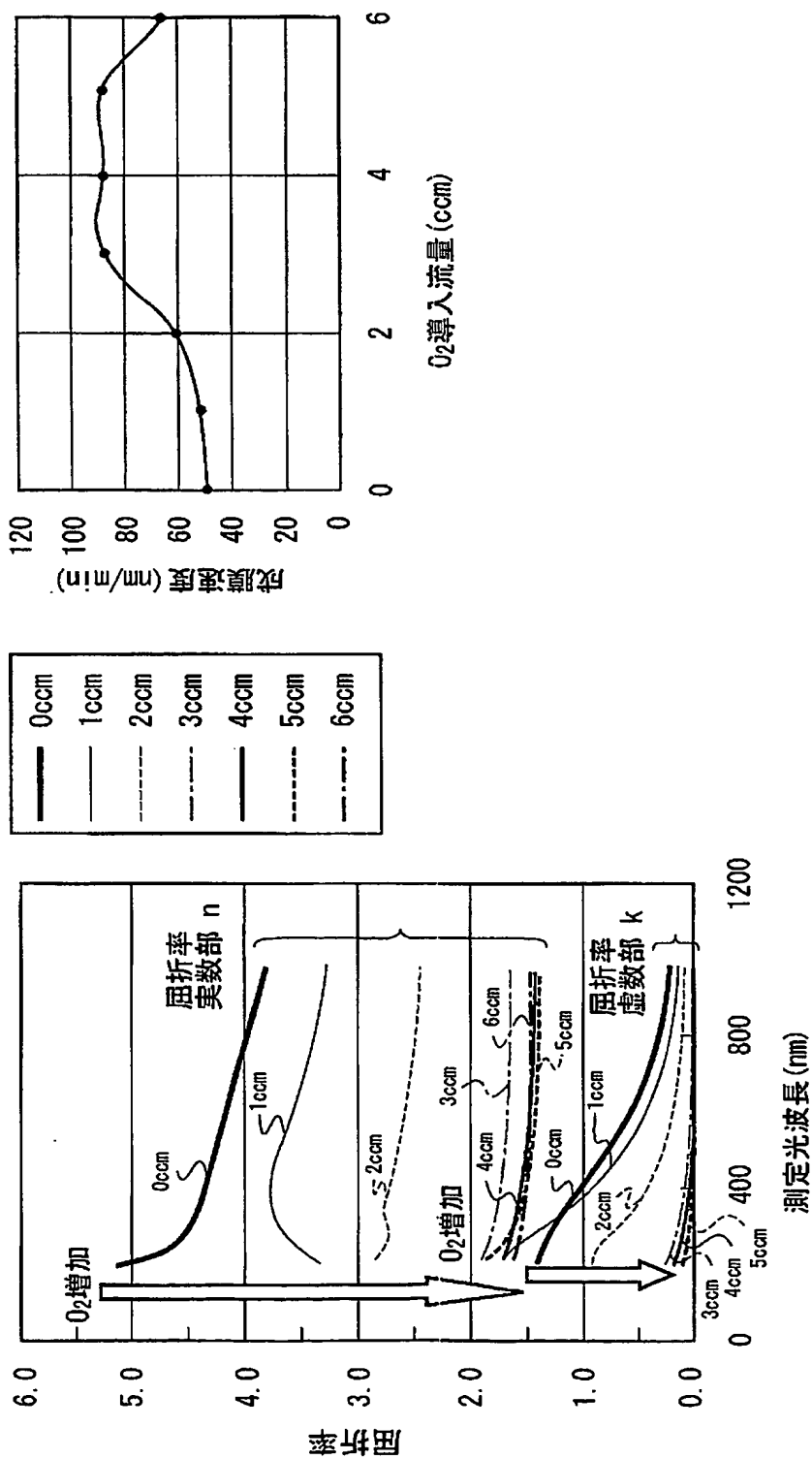
【図 3】

N₂導入流量変化、Ar導入流量10ccm一定、投入電力量500W一定



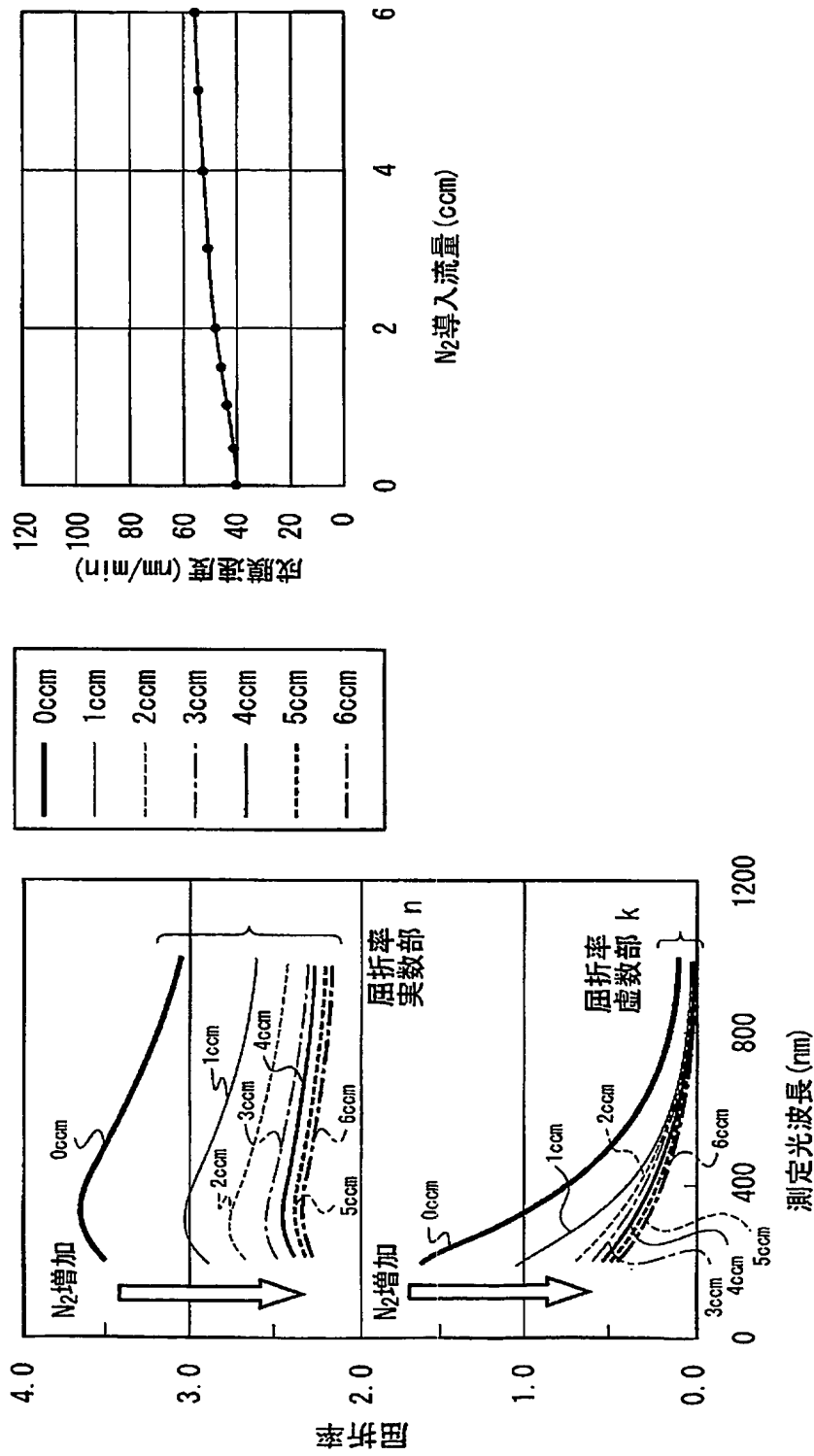
【図 4】

O₂導入流量変化、Ar導入流量10ccm一定、投入電力量500W一定



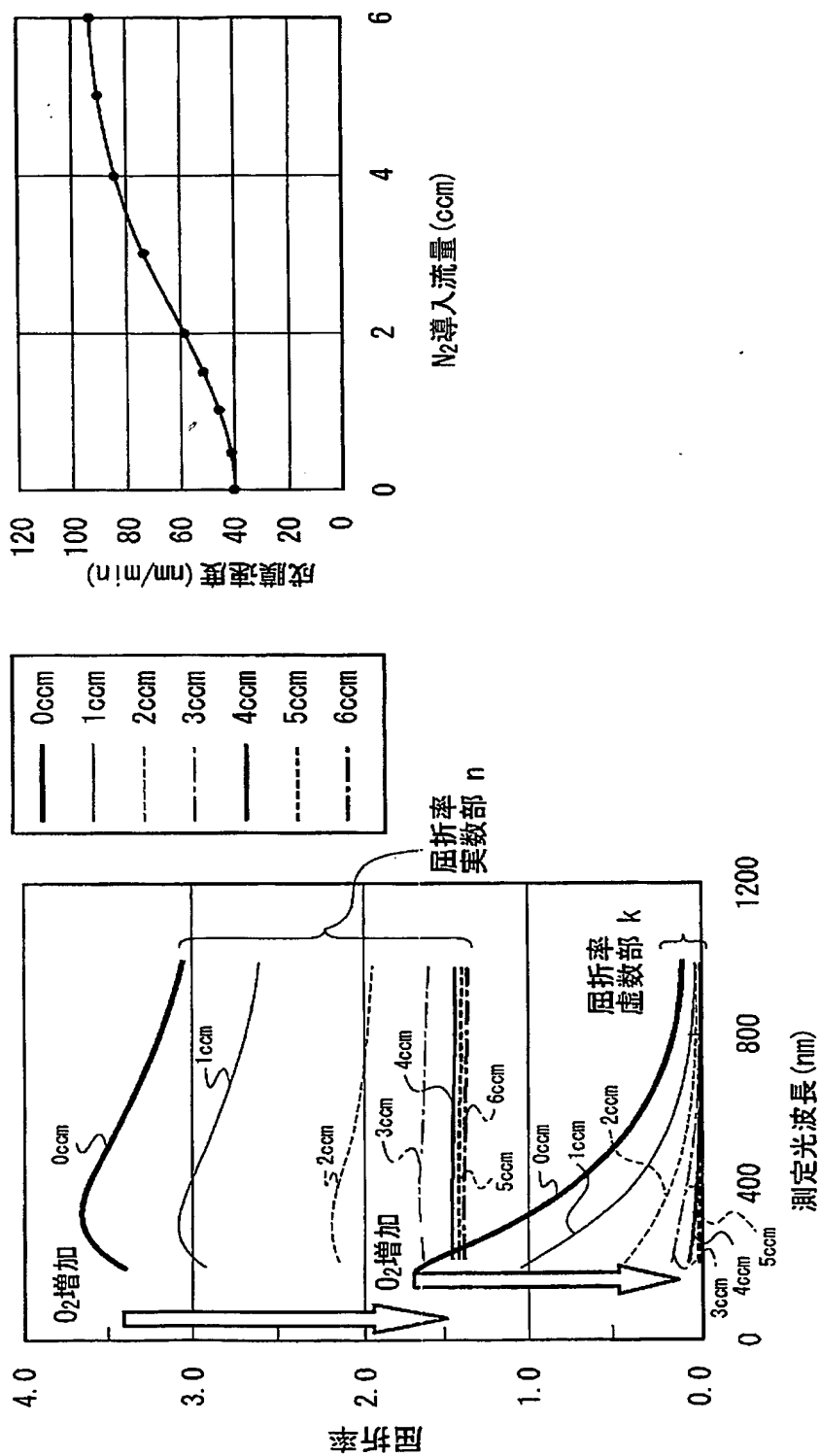
【図 5】

N₂導入流量変化、Ar導入流量10ccm一定、投入電力量500W一定



【図 6】

O₂導入流量変化、Ar導入流量10ccm一定、投入電力量500W一定



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 酸素ガスもしくは窒素ガスの流量の制御又は投入電力の制御により被覆層の屈折率を広い範囲で調整可能なスパッタリングターゲットを提供する。

【解決手段】 SiCとSiをSiC/Si（体積比率）＝50/50～70/30で含むスパッタリングターゲット。

【選択図】 なし

特願 2002-221652

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005278]

1. 変更年月日

1990年 8月27日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区京橋1丁目10番1号

氏 名

株式会社ブリヂストン

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.